



产品编号: H1M17065L

SiC 功率 MOSFET

一代 MOSFET 技术, N 沟道增强型器件

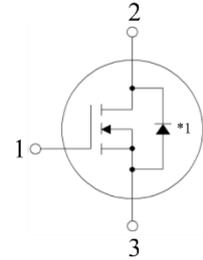
特点

低导通电阻、快开关速度
易于并联

应用

开关电源
DC-DC
电机驱动

V_{DS}	650V
$I_D@25^{\circ}C$	118A
$R_{DS(on)}$	17m Ω



- 1 栅极
- 2 漏极
- 3 源极
- *1 体二极管

产品型号	芯片尺寸
H1M17065L	4.6 mm * 6.2

额定参数 (除特别声明外 $T_C=25^{\circ}C$)

mm

符号	参数	值	单位	测试条件	备注
V_{DSmax}	漏源电压	650	V	$V_{GS}=0V, I_D=1mA$	
V_{GSmax}	栅源电压	-10/+25	V	栅源电压最大值	
V_{GSop}	栅源电压	-5/+20	V	驱动电压建议值	
I_D	连续漏极电流	118	A	$V_{GS}=20V, T_C=25^{\circ}C$	
T_J	工作结温	150	$^{\circ}C$		
T_{stg}	存储温度	-55~+150	$^{\circ}C$		

电参数 (除特别声明外 $T_C=25^{\circ}C$)

符号	参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件	备注
$V_{(BR)DSS}$	漏源击穿电压	650	/	/	V	$V_{GS}=0V, I_D=1mA$	
$V_{GS(th)}$	栅阈值电压	2	2.6	4	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=23.5mA$	
			2.0			$V_{DS}=V_{GS}, I_D=23.5mA, T_J=150^{\circ}C$	
I_{DSS}	零栅压漏电流	/	1	50	μA	$V_{GS}=0V, V_{DS}=650V$	
I_{GSS}	栅源漏电流	/	/	± 250	nA	$V_{DS}=0V, V_{GS}=-10/+25V$	
$R_{DS(on)}$	通态源漏电阻		17	23	m Ω	$V_{GS}=20V, I_D=50A$	
			22			$V_{GS}=20V, I_D=50A, T_J=150^{\circ}C$	

体二极管参数 (除特别声明外 $T_C=25^{\circ}C$)

符号	参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件	备注
V_{SD}	正向压降		4.5		V	$V_{GS}=-5V, I_F=25A$	
I_S	连续正向电流			118	A	$T_C=25^{\circ}C$	